

Abstract

The present invention relates to an ESD (Electro-Static Discharge) protection circuit, and specifically to an ESD protection circuit configured to improve an ESD protection characteristic.

An ESD protection circuit of this kind according to the present invention is characterized by being configured by including: a substrate of a first conduction type in which an activation region and a field region are defined; a well of a second conduction type formed in a predetermined area in the activation region in the substrate of the first conduction type; a first and a second high-concentration impurity regions of the first conduction type formed with a certain distance therebetween in the well of the second conduction type; a low-concentration impurity region of the first conduction type formed between the first and the second high-concentration impurity regions of the first conduction type; and a high-concentration impurity region of the second conduction type formed with a certain distance between itself and the second high-concentration impurity region of the first conduction type.

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
H01L 27/06

(11) 공개번호 특1998-043416
(43) 공개일자 1990년 08월 05일

(21) 출원번호	특1996-061263
(22) 출원일자	1996년 12월 03일
(21) 출원인	엘지반도체 주식회사 문정관 충청북도 청주시 흥덕구 향정동 1번지
(22) 발행자	박동 경기도 안양시 만안구 만일5동 387-7 12/2 최선 경기도 고양시 덕양구 관산동 281 풍일빌라 8-101 강한규 대구광역시 동구 자작동 대성빌라 105-301 강용복, 김용인
(24) 대리인	

(54) 미에스디(ESD) 보호 회로

본 발명은 ESD(Electro Static Discharge) 보호 회로에 관한 것으로 특히, ESD 보호 특성을 향상시키도록 한 ESD 보호 회로에 관한 것이다.

이와 같은 본 발명의 ESD 보호 회로는 활성형태과 펄드형태으로 정의된 제 1 도전형 기판과, 상기 제 1 도전형 기판의 활성형태의 소정 영역에 형성된 제 2 도전형 헬과, 상기 제 2 도전형 헬내에 일정한 간격을 갖고 형성되는 제 1 도전형 제 1, 제 2 펄드, 펄드 헬과, 상기 제 1 도전형 제 1, 제 2 펄드 헬과 상기 제 1 도전형 제 2 펄드 헬을 포함하여, 상기 제 1 도전형 제 2 펄드 헬과 상기 제 1 도전형 제 1 펄드 헬을 포함하여 그 특징이 있다.

도 1은 종래의 ESD 보호 회로를 나타낸 구조단면도
 도 2는 본 발명의 ESD 보호 회로를 나타낸 구조단면도
 도 3a와 도 3b는 종래와 본 발명의 동일한 전입에서 포텐셜의 차이를 나타낸 도면
 +도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명+
 21 : n형 실리콘 기판 22 : p-웰
 23 : 제 1 저항 24 : 제 2 저항 25 : n형 실리콘 26 : 전극

본 설명은 ESD(Electro Static Discharge) 보호 회로에 관한 것으로 특히, ESD 보호 특성을 할증시키도록

일반적으로 반도체 장치에 있어서, ESD(Electro Static Discharge) 보호 회로는 약 300 ~ 2000V의 고정된 대체로 300V부터 대체로 2000V의 고정된 회로로서, 상기 ESD 보호 회로의 기본에는 3가지의

이용한 방법과 필드 트랜지스터, 다이오드, 바이폴라 트랜지스터 등을 이용한 방법을 사용한다.

그런데 반도체 소자가 고정적화됨에 따라 ESD와 같은 높은 전압이 인가되는 부분(즉, 필드 트랜지스터, 바이폴라 트랜지스터 등)의 게이트 산화막은 그 두께가 얕아지기 때문에 ESD 보호 회로에 포함된 능동소자와 이 능동소자에 연결된 내부회로의 능동소자는 내부회로의 다른 능동소자보다 ESD 특성이 더욱 더 낮아지게 된다.

그래서 종래에는 이러한 ESD 특성을 놓기위한 방법으로서 HBM(Human Body Model) 방법이나 MM(machine Model) 방법을 이용하였다.

그러나 최근에 생산하고 있는 반도체 소자에 있어서는 같은 칩(chip)내에서 동일한 두께의 게이트 산화막을 이용하여 내부회로를 형성하고 있다.

그 한가지 예로 64DRAM인 경우에는 한 전체에 산화막의 두께를 약 100Å 정도로 동일하게 사용하고 있다.

더욱 같은 반도체 소자가 고정적화됨에 따라 패키지(Package) 크기가 증가하고 산화막이 얕아지기 때문에 CDM(Charged Device Model)을 이용하여 ESD 특성을 파악하는 기술이 중요하게 대두되고 있다.

상기에서 언급한 두 가지 방법(HBM, MM)에 의해 파괴되는 부분은 주로 접합 가장자리이지만, CDM에 의해 파괴되는 부분은 주로 각 능동소자의 게이트 산화막이 된다.

즉, 상기 CDM 방법에 의해 가해지는 ESD 펄스(Pulse)가 최고 전류까지 도달하는데 걸리는 시간은 약 1usec이고, 이 때 ESD 보호 회로가 동작하는데 걸리는 시간은 1usec이다.

그리므로 ESD 보호 회로가 동작하기도 전에 ESD 펄스가 ESD 보호 회로에 포함된 능동소자의 산화막과 내부회로에 연결된 능동소자의 산화막을 파괴하게 된다.

따라서 반도체 소자가 고정적화됨에 따라 ESD 보호 회로와 상기 보호 회로에 연결된 능동소자 뿐만 OHJ와 보호 회로 근방에 있는 내부회로도 ESD에 의해 영향을 받게 된다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 종래의 ESD 보호 회로를 설명하면 다음과 같다.

도 1은 종래의 ESD 보호 회로를 나타낸 구조단면도이다.

도 1에 도시된 바와 같이 활성영역과 필드영역으로 정의된 n형 실리콘 기판(11)의 활성영역의 소정역에 p-웰(12)이 형성되고, 상기 p-웰(12)내에 일정한 간격을 가지고 제 1, 제 2 고농도 n형 평순을 형성(13, 14)이 형성되며, 상기 제 2 고농도 n형 평순을 양극(14)과 일정한 간격을 두고 고농도 p형 평순을 양극(15)이 형성된다.

그리고 상기 제 1 고농도 n형 평순을 양극(13)에 접합이 인가되는 핀(Pin)이 연결되고, 상기 제 2 고농도 n형 평순을 양극(14)에는 접지전압(Vss)이 연결된다. 또한, 상기 고농도 p형 평순 양극(15)에는 전원전압(Vcc)이 연결된다.

여기서 활성영역의 구조는 n+ 양극 - p-웰 - n+ 양극의 구조를 미룬다.

상기와 같이 이루어진 종래의 ESD 보호 회로에 있어서 다음과 같은 문제점이 있었다.

즉, 전하 방전량이 적기 때문에 ESD를 효과적으로 보호하지 못한다.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로 전하 방전량을 높이도록 한 ESD 보호 회로를 제공하는데 그 목적이다.

도 1은 표면 구조

그러나 상기와 같은 종래의 ESD 보호 회로에 있어서 다음과 같은 문제점이 있었다.

즉, 전하 방전량이 적기 때문에 ESD를 효과적으로 보호하지 못한다.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로 전하 방전량을 높이도록 한 ESD 보호 회로를 제공하는데 그 목적이다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 ESD 보호 회로를 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명의 ESD 보호 회로의 구조를 나타낸 구조단면도이다.

도 2에서와 같이 활성영역과 필드영역으로 정의된 n형 실리콘 기판(21)의 활성영역의 소정역에 p-웰(22)이 형성되고, 상기 p-웰(22)에는 일정한 간격을 가지고 제 1, 제 2 고농도 n형 평순을 양극(23, 24)이 형성되며, 상기 제 2 고농도 n형 평순을 양극(24)과 일정한 간격을 두고 고농도 p형 양극(25)을 양극(26)이 형성된다.

그리고 상기 제 1, 제 2 고농도 n형 평순을 양극(23, 24) 사이에 저농도 n형 평순을 양극(25)이 형성된다.

한편, 상기 제 1 고농도 n형 평순을 양극(23)에는 외부전압이 인가되는 핀(Pin)이 연결되고, 상기 제 2

1995년 1월 1일 출판부록(20)에는 접지전압(480V)이 연결되며, 경기 고속도로 현대화사업(35)에 전원전압(480V)이 연결된다.

이어서 상기 제 1, 제 2 항과 6항 제1호 항을 제외한 (23), (24) 사이에 저농도 6월 평균을 제 1(25)에 형성되면 편과 집단간(Yes)에서 전하방전량이 증가된다.

여기서 질성구조의 구조는 $n^1 2^1 3^1 - p\text{-웰} - n^1 2^1 3^1 - p\text{-웰} - n^1 2^1 3^1$ 이 된다.

도 35와 도 36는 풍래와 문 발형의 동일한 전압에서 포텐셜의 차이를 나타낸 도면이다.

도 38와 도 39에서의 물이 정지단(Viscous Turn On)되기 위한 V_A 가 V_b 보다 크며, 여기서 상기 V_b 는 정지단을 턴온시키기 위한 중앙의 전압이고, 상기 V_b 는 정지단을 턴온시키기 위한 본 발명의 전압을 나타낸다.

그 결과 동일한 전압에서 본 탈락에 따른 ESR 보호 회로의 전하방전량이 증가함을 볼 수 있다.

미술에서 설명한 바와 같이 본 병행의 E30 보호 회로에 있어서 전후 방전Ring이 증가하면서 E30를 효과적

6000 1991 000

한국어 1

최신의 시장 월드컵으로 결의된 제 1 도전형 기관

설명 제 1 도전형 기관의 합성기체의 수증기수에 형성된 제 2 도전형 웨:

한국 제 1 도전형 제 1 세 2 경기로 第二場 比賽에 펼쳐지는 제 1 도전형 전술은

상기 제 1 도전형 제 2 관계로 허술한 영역과 일정한 간격을 갖고 형성되는 제 2 도전형 관계는 청탁금지법을 조작하여 구설수를 통한 익명하는 ESG 보호회로.

卷之二

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 도전형 세 1 고등도 등급증 양식에 의부에서 인가되는 편이 연결된 것을 특징으로 하는 ESD 보호 회로.

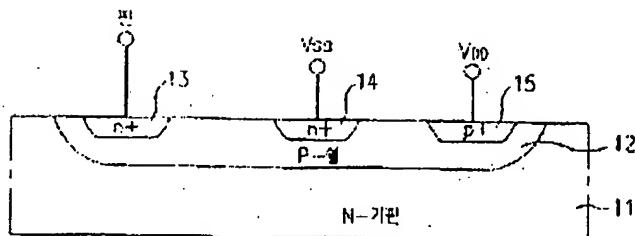
정구형 3

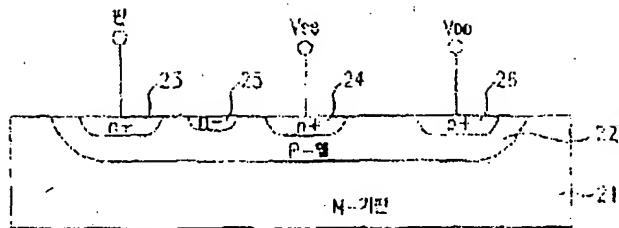
제 1 항에 있어서, 상기 제 1 도전형 제 2 고는도 날금통 영역에 접지단이 연결된 것을 특징으로 하는 ESD 보호 회로

첨구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 제 2 도전형 고농도 분순율 항액에 전원전압이 인가됨을 특징으로 하는 ESD 보호 회로.

530





4-3



4-4

